# 용매효과를 고려하는 제 1 원리결함열력학방법과 무기할로겐 페로브스카이트재료 CsPbI3의 빈자리결함특성

계윤혁, 유철준

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 교시하시였다.

《새 재료부문을 발전시키지 않고서는 전자공업을 주체적으로 발전시킬수 없고 기계 공업의 현대화를 실현할수 없으며 최신과학기술을 전반적으로 발전시킬수 없습니다.》 (《김정일선집》 중보판 제15권 487폐지)

무기할로겐페로브스카이트재료 CsPbI<sub>3</sub>의 결함물리적성질을 옳게 해명하는것은 페로브스카이트태양전지의 빛전기변환성능과 안정성을 개선하는데서 매우 중요한 문제로나선다.

우리는 주위용매효과를 고려하는 제1원리결함열력학방법의 형식론을 새롭게 제기하고 CsPbI<sub>3</sub>의 빈자리결함특성을 고찰하였다.

## 1. 용매효과를 고려하는 제 1 원리결함열력학방법

제1원리결함열력학방법[1]은 반도체와 유전체를 비롯한 고체결정들의 결함특성을 리론적으로 연구하기 위한 방법으로서 최근에 혼성 및 무기할로겐페로브스카이트재료를 비롯한 빛변환재료들에 많이 적용되고있다.[2,3]

이 방법에서 기본물리적량인 결함형성에네르기는 다음과 같이 계산된다.

$$\Delta H_f[D^q] \cong E[D^q] - E_{\text{Align}} - \sum_i n_i \mu_i + q E_F + E_{\text{Lig}}$$
 (1)

여기서  $\Delta H_f[D^q]$ 는 전하 q로 대전된 결함 D의 형성엔탈피이고  $E_{M \rightarrow M}$ 와  $E[D^q]$ 는 각각 결함없는 초세포와 결함있는 초세포의 전에네르기들이다.  $n_i$ ,  $\mu_i$  는 각각 결함이 형성될때 들어가거나(+) 나간(-) i원자의 개수와 화학포텐샬이고  $E_F$ 는 전자저장소의 화학포텐샬을 나타내는 페르미에네르기이다. 한편  $E_{\mbox{\scriptsize $L$}}$ 정 은 주기적인 초세포의 유한크기와 띠점유효과, 결함형성에 의한 정전기적포텐샬밀림으로부터 얻어지는 보정항이다.

고체의 결함형성에 미치는 주위조건의 영향은 중성전하를 띤 성분원소들의 화학포텐 샬에 반영된다. 그러나  $CsPbI_3$ 과 같이 이온결합을 이루고 전해질용액환경에서 합성 또는 분해되는 재료에 대하여서는 용매화된 이온들의 화학포텐샬을 리용하는것이 보다 적합하며 필수적이다. 액상반응을 리용한 제조과정에 조성되는 열력학적평형조건에서  $CsPbI_3$ 의 결함물리적성질들을 연구하기 위하여 선행의 제1원리결함열력학방법[1]을 용매효과를 고려할수 있도록 다음과 같이 변형한다.

$$\Delta G_{f}[D^{q}](T, P) \cong E[D^{q}](T, P) - G_{\mathbb{A}^{[\frac{q_{i}}{2}]}}(T, P) - \sum_{i} n_{i} \mu_{i}^{q_{i}}(T, P) + (q - \sum_{i} n_{i} q_{i}) E_{F} \cong$$

$$\cong E[D^{q}] - E_{\mathbb{A}^{[\frac{q_{i}}{2}]}} - \sum_{i} n_{i} \mu_{i}^{q_{i}}(T, P) + (q - \sum_{i} n_{i} q_{i}) E_{F} + E_{\mathbb{B}^{[\frac{q_{i}}{2}]}}$$
(2)

여기서 G는 유한온도와 압력에서의 깁즈자유에네르기이고  $\mu_i^{q_i}$ 는 주위용액속에 존재하는 q;로 대전된 i이온의 화학포텐샬이다. 적당한 결함농도와 온도에서 결함의 배치엔트로피 와 진동엔트로피효과는 무시할수 있으며 깁즈자유에네르기는 형성엔탈피로 근사화된다.

용매화된 이온들이 들어가거나 빠지면 초기에 결함은  $q = \sum_{i=1}^n n_i q_i$ 의 전하상태를 가지 며 이것은 종전의 초기결함상태 q=0과 차이난다. 이 초기상태가 전자저장소와 호상작용 하여  $q \neq \sum_{i=1}^{n} n_i q_i$  의 상태들이 발생한다. 이온농도나 pH와 같은 실험관측량으로부터 수용 액속에서의 이온화학포텐샬  $(\mu_i^{q_i})_{\uparrow \& \circlearrowleft}$  을 얻어낸다면 식 (2)를 리용하여 용매효과를 고려 한 고체의 결함형성에네르기를 계산할수 있다.

# 2. CsPbI3의 빈자리결함형성에네르기

제1원리계산에서는 PAW포텐샬과 PBEsol교환상관범함수, VASP코드를 리용하였다. 심 및 값전자들에 대하여 스칼라상대론적보정을 하고 Cs-5s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup>6s<sup>1</sup>, Pb-5d<sup>10</sup>6s<sup>2</sup>6p<sup>2</sup>, I-5s<sup>2</sup>5p<sup>5</sup>의 배 치를 주었다.

먼저  $\alpha$ 상과  $\delta$ 상의 최적화된 단위포구조를 얻고 그로부터 각각  $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 1$ 의 초세포를 만들었다. 다음 할로겐페로브스카이트재료에서 기본결함들인 빈자리결함들( $V_{Cs}$ ,  $V_{p_h},\ V_I$ )을 형성시키고 평면파절단반경  $400 \mathrm{eV}$ 와  $2 \times 2 \times 2$ 의 k점그물로 구조완화와 전에 네르기계산을 진행하였다. 다음 두 상들에 대하여 각각 19.5. 12.4의 정적유전상수들을 얻 어내고 유한크기효과를 보정하였으며 Pb-5d심준위를 리용하여 결합형성에 의한 정전기포 텐샬밀림을 계산하였다. 띠점유효과보정은 얕은 준위를 형성시키는  $V_{L}^{0}$ ,  $V_{Cc}^{0}$ ,  $V_{ph}^{0}$ ,  $V_{ph}^{-1}$ 결합상태들에 대하여 진행하였다.

그림 1에 빈자리결함이 없는 경우와 있는 경우에 완화된 초세포의 원자적구조를 보 여주었다.

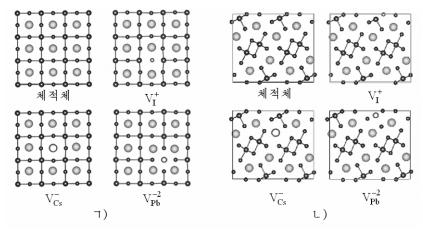


그림 1. 빈자리결함이 없는 경우와 있는 경우에 완화된 초세포의 원자적구조 기 α상, L) δ상

단위포에서  $\alpha$  상과  $\delta$  상의 금지띠너비는 각각 1.19, 2.45eV이다. 두 상의 빈자리결함

들에 대하여 식 (1), (2)를 각각 적용하고 형성에네르기를 평가하였다. CsPbI<sub>3</sub>을 둘러싼 계의 열력학적평형조건은 중성 및 대전된 구성성분들에 의하여 다음과 같이 표시된다.

$$\mu_{\text{Cs}} + \mu_{\text{Pb}} + 3\mu_{\text{I}} = \mu_{\text{CsPbI}_3} = \mu_{\text{Cs}}^+ + \mu_{\text{Pb}}^{2+} + 3\mu_{\text{I}}^-$$
 (3)

$$\mu_{Pb} + 2\mu_{I} = \mu_{PbI_{2}} = \mu_{Pb}^{2+} + 2\mu_{I}^{-} \tag{4}$$

$$\mu_{\rm Cs} + \mu_{\rm I} = \mu_{\rm CsI} = \mu_{\rm Cs}^+ + \mu_{\rm I}^- \tag{5}$$

우의 식들에서 왼변은 중성원자들에 해당되고 오른변은 이온들에 해당된다.

먼저 식 (3)-(5)를 리용하여 열력학적평형조건에서 중성구성원자들의 화학포텐샬범 위를 확정하고 식 (1)을 리용하여 빈자리결함들의 형성에네르기를 계산하였다.(그림 2)

이때  $\alpha$ -CsPbI $_3$  의 금지띠너비는  $E_g$  =1.19eV 이며  $\delta$ -CsPbI $_3$  의 금지띠너비는  $E_g$  = 2.45eV 이다. 요드와 연의 풍부조건은 그것들의 체적체상들에 대응하며 그것들의 결핍조건은 식 (4)에서  $\mu_{\mathrm{PbI}_2} \approx E_{\mathrm{DFT}}(\mathrm{PbI}_2)$  에 의하여 계산된다. CsI의 용해도는 PbI $_2$  과 CsPbI $_3$  에 비하여 매우 작으므로 함께 공존하기가 어려우며 따라서 식 (5)에서  $\mu_{\mathrm{CsI}} \approx E_{\mathrm{DFT}}(\mathrm{CsPbI}_3) - E_{\mathrm{DFT}}(\mathrm{PbI}_2)$ 을 리용하여 세시움의 풍부조건과 결핍조건을 얻는다.

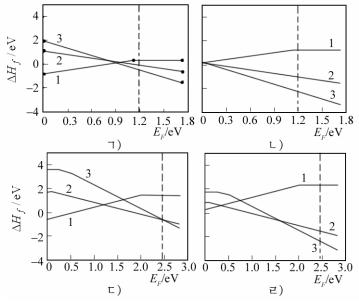


그림 2. 중성원소의 화학포텐샬에 기초한 빈자리결함형성에네르기  $\Box$ ,  $\Box$ )는 요드결핍인 경우의  $\alpha$ 상과  $\delta$ 상,  $\Box$ ),  $\Box$ )는 요드풍부인 경우의  $\alpha$ 상과  $\delta$ 상 1-3은 빈자리결함들이  $V_{\rm I}, V_{\rm Cs}, V_{\rm Pb}$  인 경우

요드풍부와 결핍조건에서  $\delta$ 상의 결함형성에네르기는  $\alpha$ 상보다 크며 이것이  $\delta$ 상안 정성의 원인으로 된다.  $\delta$ 상에서  $V_{\rm I}$ 의 열력학적이행준위  $\varepsilon(0/+1)$ 은 전도띠최소비점유준위(CBM)보다  $0.44{\rm eV}$ 아래에 놓여있고  $V_{\rm Pb}$ 는 값전자띠최대점유준위(VBM)보다  $0.52{\rm eV}$ 우에 놓이면서 깊은 포획준위를 형성한다. 원인은  $\delta$ 상에서 Pb 6s-I 5p 반결합세기가  $\alpha$ 상에 비하여 약하기때문이다.

수화된 이온들의 화학포텐샬을 결정하고 그것에 기초하여 식 (2)를 리용한 새로운

방법으로 lpha 상과  $\delta$  상들의 빈자리결합형성에네르기를 계산하였다.(그림 3) 일반성을 잃 지 않고 방안온도에서 1,  $10^{-20}$ mol/kg의 몰랄농도들을 각각 연의 풍부 및 결핍조건으로 주었다. 식 (3)-(5)의 오른변들을 리용하여 요드와 세시움이온들의 화학포텐샬범위를 우 에서와 류사한 방식으로 규정하였다. 그러나 CsPbl3과 Pbl3의 유한온도에서의 화학포텐샬 은 실험자료를 리용하여 보정하였다. 결핍조건과 풍부조건사이에서 매 이온들이 가질수 있는 임의의 화학포텐샬중간값은 해당한 조건에서의 이온농도로부터 계산된다.

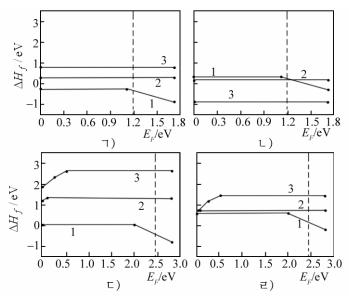


그림 3. 대전된 이온들의 화학포텐샬에 기초한 빈자리결함형성에네르기 기), 다)는 요드이온이 결핍인 경우  $\alpha$ 상과  $\delta$ 상, 나), 리)는 요드이온이 풍부인 경우  $\alpha$ 상과  $\delta$ 상 1-3은 빈자리결함들이  $V_{\rm I}, V_{\rm Cs}, V_{\rm Pb}$ 인 경우

그림 3에서 보는바와 같이  $E_r$ 에 대한 형성에네르기선의 경사도가 같은 종류의 결함 에 대하여 그림 2에서와 차이난다. 특히 Cs와 Pb, I빈자리결함들이 -1, -2, +1로 대전되 였을 때 경사도는 0으로서 페르미에네르기축과 평행이다. 이것은 주요전하상태로 대전된 빈자리결함들의 형성에네르기가 선행방법에서의 중성결함상태처럼 페르미에네르기에 무 관계하다는것을 의미한다. 이러한 차이는 식 (1)과 (2)에서  $E_{
m F}$ 의 곁수가 각각 q ,  $(q-\sum n_iq_i)$  인것과 관련된다. 그러나 두가지 방법에서 열력학적이행준위  $\varepsilon(q_1/q_2)$ 은 일치 하며 이를 통하여 새로운 형식론에서 체적체재료의 고유결함특성은 변하지 않는다는것을 알수 있다.

#### 맺 는 말

용매효과를 고려하는 제1원리결핚열력학방법을 제기하고 그것을 리용하여 무기할로 겐페로브스카이트 CsPbI<sub>3</sub>의 빈자리결함형성에네르기를 계산하였다. 계산결과로부터 대부 분의 CsPbI;합성에서는 주로 극성유기용매를 리용하며 이때 용매화된 이온들의 화학포텐 샬을 정확히 평가하기 위해서는 수용액에서의 화학포텐샬값에 다른 유기용매의 효과를 음적으로 고려하여 얻은 제1원리전에네르기를 보정하여야 한다.

## 참 고 문 헌

- [1] C. Freysoldt et al.; Rev. Mod. Phys., 86, 253, 2014.
- [2] Y. H. Kye et al.; J. Phys. Chem. Lett., 9, 2196, 2018.
- [3] Y. Huang et al.; J. Phys. Chem., C 122, 1345, 2018.

주체108(2019)년 9월 5일 원고접수

# Ab Initio Thermodynamics for Defects Considering the Solvent Effect and Vacancy Defects Properties in Inorganic Perovskite CsPbI<sub>3</sub>

Kye Yun Hyok, Yu Chol Jun

Defect physics of inorganic perovskite CsPbI<sub>3</sub> is an important factor which determines the performance and stability of perovskite-based solar cells. In this paper we formalized a new method to consider the solvent effect when using the ab initio thermodynamics for defects, and applied it to the vacancy properties of CsPbI<sub>3</sub>.

Keywords: perovskite solar cell, solvent effect, defect formation energy, thermodynamics